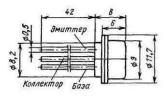
## 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, KT603E

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п импульсные высокочастотные маломощные Предназначены для применения в импульсных и переключательных высокочастотных схемах

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 1,75 г.

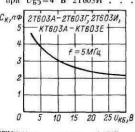


Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

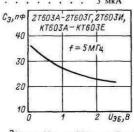


## Электрические параметры

при $I_{\rm K} = 150$ мA, $I_{\rm B} = 15$ мA:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более	0,8 B
типовое значение	0,2* B
типовое значение	
не более	1,0 B
при $I_{\rm K} = 350$ мА, $I_{\rm B} = 50$ мА 2Т603И не более	1,2 B
Напряжение насыщения база-эмиттер:	
при $I_{\rm K} = 150$ мA, $I_{\rm B} = 15$ мA:	
27603А, 27603Б, 27603В, 27603Г, КТ603А, КТ603Б,	
КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более	1,5 B
тнповое значение прн $I_{\rm k} = 350$ мА, $I_{\rm b} = 50$ мА 2Т603И не более	0,9* B 1,3 B
при $I_{\rm K} = 350$ мА, $I_{\rm B} = 50$ мА 2160341 не более	1,0 B
типовое значение	1,0 В
эмиттером при $U_{KB} = 2$ В при $T = 298$ K;	
при І∋=150 мА.	
2Т603А, 2Т603В, КТ603Д	20 - 80
KT603A, KT603B	10 - 80
2Т603Б, 2Т603Г	60 - 180
КТ603Б, КТ603Г не менее	60
KT603E	60 - 200
при $I_3 = 350$ мА 2Т603И не менее	1000
типовое значение	50*
при $T = 213$ K, $I_2 = 150$ мA.	
2T603A, 2T603B	8 - 80
2Т603Б, 2Т603Г	20 - 180
2Т603И не менее	8
при $T = 398$ K, $I_3 = 150$ мА	
21603A, 21603B	20 - 180
2Т603Б, 2Т603Г	60 - 400
2Т603Б, 2Т603Г	20
$_{\rm mac}$ рассасывания при $I_{\rm w} = 150$ мА. $I_{\rm p} = 15$ мА:	71.1
время рассыя 2T603A, 2T603B, 2T603Г, 2T603И не бо-	
пее	70 нс
типовое значение	40* нс
KT603A, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	100
не более	100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{K3} = 10$ В,	400
$I_3 = 30$ мA, $f = 5$ МГц не более	400 nc 25* nc
типовое значение	23. HC
граничная частога передачи тока в схеме с общим эмиг- тером при $U_{K3} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, не менее	200 МГп
типовое значение	
типовое значение:  Емкость коллекторного перехода при $U_{K\Im} = 10 \text{ B}, f = 5 \text{ МГц}$	270 1911
EMROCIE ROSSICATOPHOTO REPEACE A PAR C K3 = 10 D; ) = 5 MI H	15 пФ
не более	3* пФ
$E_{MKOCT}$ эмиттерного перехода при $U_{36}=0$ , $f=5$ МГ $\mathfrak{n}$	F200 (1202)
ие более	40 пФ
не более	35* пФ
Обратным ток коллектора, не более	
при $T = 298$ K при $U_{VS} = 30$ В	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 MKA
КТ603А, КТ603Б	10 MKA
при $U_{KB} = 15$ В	
2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
2Т603B, 2Т603Г	5 MKA
при $U_{KB} = 10$ В КТ603Д, КТ603Е	І мкА
при $T = 398$ К	
при $U_{KB} = 24$ В 2Т603A, 2Т603B, 2Т603И	
	60 мкА
Обратный ток эмизтера не более	
при $U_{\text{DE}} = 3$ В 2Т603A, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г,	
2T603A, KT603B, KT603B, KT603F, KT603A, KT603E	3 мкА
при $U_{\rm EG} = 4$ В 2Т603И ,	3 мкА



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.

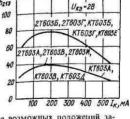


Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.

Предельны	еэ	KC	nny	ат	аці	юн	ны	е д	аш	ње			
Постоянное напряжение ко	770	vT	on	50	20	u v	07	101	TO	_			
эмиттер при $R_{53} \le 1$ кО	h	N.	op.	va	3a	n n	OJL	ICK	10				
при Т ≤ 343 К	·NI												
											20	n	
КТ603A, КТ603Б .	•	٠		•						•	30		
КТ603В, КТ603Г .		•	•			•	٠		•		15		
КТ603Д, КТ603Е.		٠									10	B	
при <i>T</i> <sub>п</sub> ≤ 373 К	_											_	
2Т603А, 2Т603Б, 2	16	03.	И						•		30		
2Т603В, 2Т603Г.							•			•	15	В	
$при_{n} T_{n} = 393 \text{ K}$													
КТ603А, КТ603Б.		٠					•				15	B	
КТ603В, КТ603Г.		•									7,5	B	
КТ603Д, КТ603Е.											10	В	
при $T = 398$ K:													
2Т603А, 2Т603Б, 2Т	603	и									24	В	
2Т603В, 2Т603Г.											12	В	
при $T = 423$ K:													
2Т603А, 2Т603Б, 2Т	603	И		72			23		749	2	18	В	
2Т603В, 2Т603Г .		-			1		500					В	
Напряжение эмиттер-база			-		-				-	8	1	100	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т6		1	21	603	T						2	В	
2Т603И при $T_{\rm H} \le 343$												В	
2Т603И при $T_0 = 398$	K	ŧ.	•	•			•	•	13.00	9.00		В	
Постоянный ток коллекто		•			•	•	•				300		
Импульсный ток коллекто	pa	•				- 10		•		88.8	300	MA	
импульсный ток коллект	opa	1	ipu	1	H =	11	,	MK	,		(00		
Q ≥ 10	•	•	٠			•	•			•	600	MA	
Постоянная рассеиваемая	мо	Щ	100	ТЬ							0.5		
при Т ≤ 323 К							•			100	0,5	BT	
при $T = 358$ К КТ													
КТ603Г, КТ603Д, КТ													
2Т603Б, 2Т603В, 2Т6	031	,	21	603	зи	•				•	0,12	B <sub>T</sub>	
Температура перехода:	_												
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603											423	K	
КТ603А, КТ603Б, КТ							K	T6	03,	Д,			
KT603E		٠				٠	•	•		•	393		
Общее тепловое сопроти							•			•	200	К/Вт	
Температура окружающей													
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603											r 213 .	10 39	8 K
КТ603А, КТ603Б, КТ	60	3B	, ]	KT	603	ЗΓ,	K	T6	03,	Д,			
KT603E										. 0	r 233 ,	20 35	8 K
Примечание. Расс	TOS	ш	ie	OT	K	opr	Iyc	a ,	10	нача	ла из	гиба	вы-
вода 3 мм.													
Не допускается пайка	В	ыв	ОД	ОВ	Ha	r	acc	CTO	ян	ии м	енее :	MM C	от
корпуса. Пайку выводов													
температуре не более 543 В													
пайки.	0000	505	ar53670		1725	STAN USE	35700	2000	~	TO THE PARTY	VEX. 23.10(24)		
Запрещается кручение	Bh	ВС	ДО	ВБ	OK	DVI	. 0	СН					
-map - market apy tenne			-		1	rJ.							



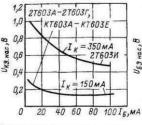


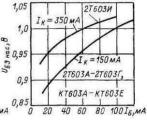




Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

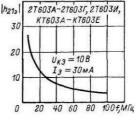
висимости статического коэффициента передачи тока от напря. жения коллектор-эмиттер.

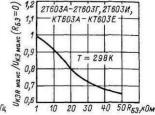




Зависимость напряжения насыколлектор-эмиттер тока базы.

Зависимость напряжения насыбазы.





модуля коэффи-Зависимость циента передачи тока от часто-ты.

Зависимость максимального допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопр-ния база-эмиттер. сопротивле-